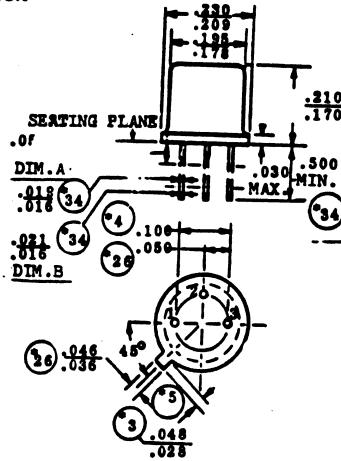


**2N3250,A**  
**2N3251,A**

CASE 22, STYLE 1  
TO-18 (TO-206AA)

GENERAL PURPOSE TRANSISTOR  
PNP SILICON



**MAXIMUM RATINGS**

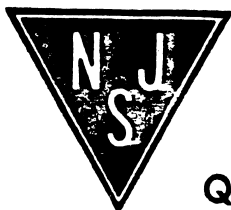
Rating	Symbol	2N3250 2N3251	2N3250A 2N3251A	Unit
Collector-Emitter Voltage	V <sub>CEO</sub>	40	60	Vdc
Collector-Base Voltage	V <sub>CBO</sub>	50	60	Vdc
Emitter-Base Voltage	V <sub>EBO</sub>	5.0		Vdc
Collector Current	I <sub>C</sub>	200		mAdc
Total Device Dissipation @ T <sub>A</sub> = 25°C Derate above 25°C	P <sub>D</sub>	0.36	2.06	Watt mW/°C
Total Device Dissipation @ T <sub>C</sub> = 25°C Derate above 25°C	P <sub>D</sub>	1.2	6.9	Watts mW/°C
Operating and Storage Temperature Temperature Range	T <sub>J</sub> , T <sub>stg</sub>	-65 to +200		°C

**THERMAL CHARACTERISTICS**

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction to Case	R <sub>θJC</sub>	0.15	mW/°C
Thermal Resistance, Junction to Ambient	R <sub>θJA</sub>	0.49	mW/°C

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T<sub>A</sub> = 25°C unless otherwise noted.)**

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
<b>OFF CHARACTERISTICS</b>				
Collector-Emitter Breakdown Voltage (1) (I <sub>C</sub> = 10 mAdc)	V <sub>(BR)CEO</sub>	40 60	—	Vdc
Collector-Base Breakdown Voltage (I <sub>C</sub> = 10 μAdc)	V <sub>(BR)CBO</sub>	50 60	—	Vdc
Emitter-Base Breakdown Voltage (I <sub>E</sub> = 10 μAdc)	V <sub>(BR)EBO</sub>	5.0	—	Vdc
Collector Cutoff Current (V <sub>CE</sub> = 40 Vdc, V <sub>BE</sub> = 3.0 Vdc)	I <sub>CEX</sub>	—	20	Adc
Base Cutoff Current (V <sub>CE</sub> = 40 Vdc, V <sub>BE</sub> = 3.0 Vdc)	I <sub>BL</sub>	—	50	nAdc
<b>ON CHARACTERISTICS</b>				
DC Forward Current Transfer Ratio (1) (I <sub>C</sub> = 0.1 mAdc, V <sub>CE</sub> = 1.0 Vdc)	h <sub>FE</sub>	40 80	—	—
(I <sub>C</sub> = 1.0 mAdc, V <sub>CE</sub> = 1.0 Vdc)		45 90	—	
(I <sub>C</sub> = 10 mAdc, V <sub>CE</sub> = 1.0 Vdc)		50 100	150 300	
(I <sub>C</sub> = 50 mAdc, V <sub>CE</sub> = 1.0 Vdc)		15 30	—	
Collector-Emitter Saturation Voltage (1) (I <sub>C</sub> = 10 mAdc, I <sub>B</sub> = 1.0 mAdc) (I <sub>C</sub> = 50 mAdc, I <sub>B</sub> = 5.0 mAdc)	V <sub>CE(sat)</sub>	—	0.25 0.5	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage (1) (I <sub>C</sub> = 10 mAdc, I <sub>B</sub> = 1.0 mAdc) (I <sub>C</sub> = 50 mAdc, I <sub>B</sub> = 5.0 mAdc)	V <sub>BE(sat)</sub>	0.6	0.9 1.2	Vdc
<b>SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS</b>				
Current-Gain — Bandwidth Product (I <sub>C</sub> = 10 mAdc, V <sub>CE</sub> = 20 Vdc, f = 100 MHz)	f <sub>T</sub>	250 300	—	MHz
Output Capacitance (V <sub>CB</sub> = 10 Vdc, I <sub>E</sub> = 0, f = 100 kHz)	C <sub>obo</sub>	—	6.0	pF
Input Capacitance (V <sub>CB</sub> = 1.0 Vdc, I <sub>C</sub> = 0, f = 100 kHz)	C <sub>ibo</sub>	—	8.0	pF





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.